

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

In re U.S. Patent Application of

ONO et al.

Application Number: To Be Assigned

Filed: Concurrently Herewith

For: LIQUID CRYSTAL DISPLAY DEVICE

**Honorable Assistant Commissioner
for Patents
Washington, D.C. 20231**

1c872 U.S. PTO
10/051185
01/22/02

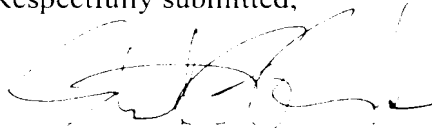
**REQUEST FOR PRIORITY
UNDER 35 U.S.C. § 119
AND THE INTERNATIONAL CONVENTION**

Sir:

In the matter of the above-captioned application for a United States patent, notice is hereby given that the Applicant claims the priority date of January 29, 2001, the filing date of the corresponding Japanese patent application 2001-019386.

The certified copy of corresponding Japanese patent application 2001-019386 is being submitted herewith. Acknowledgment of receipt of the certified copies is respectfully requested in due course.

Respectfully submitted,



Stanley P. Fisher
Registration Number 24,344

REED SMITH LLP
3110 Fairview Park Drive
Suite 1400
Falls Church, Virginia 22042
(703) 641-4200
January 22, 2002

JUAN CARLOS A. MARQUEZ
Registration No. 34,072

日 本 国 特 許 庁
JAPAN PATENT OFFICE

Jc872 U.S. PTO
10/051185
01/22/02

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office

出 願 年 月 日

Date of Application:

2001年 1月29日

出 願 番 号

Application Number:

特願2001-019386

出 願 人

Applicant(s):

株式会社日立製作所

2001年 8月31日

特 許 庁 長 官
Commissioner,
Japan Patent Office

及 川 耕 造

出証番号 出証特2001-3079265

【書類名】 特許願

【整理番号】 330100006

【あて先】 特許庁長官殿

【国際特許分類】 G02F 1/133

【発明者】

 【住所又は居所】 千葉県茂原市早野 3 3 0 0 番地 株式会社日立製作所ディスプレイグループ内

 【氏名】 小野 記久雄

【発明者】

 【住所又は居所】 千葉県茂原市早野 3 3 0 0 番地 株式会社日立製作所ディスプレイグループ内

 【氏名】 落合 孝洋

【発明者】

 【住所又は居所】 千葉県茂原市早野 3 3 0 0 番地 株式会社日立製作所ディスプレイグループ内

 【氏名】 桶 隆太郎

【発明者】

 【住所又は居所】 千葉県茂原市早野 3 3 0 0 番地 株式会社日立製作所ディスプレイグループ内

 【氏名】 仲吉 良彰

【発明者】

 【住所又は居所】 千葉県茂原市早野 3 3 0 0 番地 株式会社日立製作所ディスプレイグループ内

 【氏名】 倉橋 永年

【特許出願人】

 【識別番号】 000005108

 【氏名又は名称】 株式会社 日立製作所

【代理人】

 【識別番号】 100075096

【弁理士】

【氏名又は名称】 作田 康夫

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 013088

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 液晶表示装置

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 第1と第2の透明な基板と、前記第1と第2の基板間に挟まれた液晶層を有し、前記第1の基板は複数の映像信号線、複数の走査信号線、及び前記映像信号線と前記走査信号線に囲まれた領域として形成される複数の画素領域を有し、各画素領域は少なくとも1つのアクティブ素子と画素電極を有し、該画素電極と前記液晶層の間にカラーフィルター層を有する液晶表示装置において、

走査信号線延在方向に隣接する画素のカラーフィルターの境界が前記映像信号線上に位置づけられていると共に、該境界部と該映像信号線に重畳して前記カラーフィルターと前記液晶層の間に遮光層が形成されていることを特徴とする液晶表示装置。

【請求項 2】 前記遮光層と前記カラーフィルターの間に有機平坦化膜が形成されていることを特徴とする請求項1記載の液晶表示装置。

【請求項 3】 共通電極及び共通電極を兼ねた共通信号線が前記カラーフィルターの形成された基板の前記カラーフィルター上に設けられていることを特徴とする請求項1記載の液晶表示装置。

【請求項 4】 共通電極及び共通電極を兼ねた共通信号線が前記カラーフィルターの形成された基板の前記有機平坦化膜上に設けられていることを特徴とする請求項2記載の液晶表示装置。

【請求項 5】 共通電極及び共通電極を兼ねた共通信号線が前記カラーフィルターの形成された基板上の前記カラーフィルターと前記液晶層の間に設けられ、該共通信号線は前記遮光層を兼ねることを特徴とする請求項1乃至4のいずれかに記載の液晶表示装置。

【請求項 6】 前記共通信号線が前記映像信号線上で前記遮光層を覆うことを特徴とする請求項1乃至4記載の液晶表示装置。

【請求項 7】 第1と第2の透明な基板と、前記第1と第2の基板間に挟まれた液晶層を有し、前記第1の基板は複数の映像信号線、複数の走査信号線、及び前記映像信号線と前記走査信号線に囲まれた領域として形成される複数の画素領域を有し

、各画素領域は少なくとも1つのアクティブ素子と画素電極と共通電極とを有し、該画素電極と前記液晶層の間にカラーフィルターを有する液晶表示装置において、

前記共通電極は前記カラーフィルタより上層に形成され、前記画素電極は前記カラーフィルタより下層に形成され、前記カラーフィルターは前記画素領域において少なくとも前記画素電極全面に重畳していることを特徴とする液晶表示装置。

【請求項 8】前記カラーフィルタと前記共通電極の間に有機平坦化膜が形成されていることを特徴とする請求項7記載の液晶表示装置。

【請求項 9】前記画素電極が面状であり、前記共通電極が線状領域を有しすることを特徴とする請求項7あるいは8のいずれかに記載の液晶表示装置。

【請求項 10】前記共通電極の一部は前記映像信号線上に重畳して配置され、共通信号線を兼ねることを特徴とする請求項7乃至9のいずれかに記載の液晶表示装置。

【請求項 11】前記共通電極の一部は前記走査信号線上に重畳して配置され、共通信号線を兼ねることを特徴とする請求項7乃至9のうちいずれかに記載の液晶表示装置。

【請求項 12】前記共通電極の一部は前記走査信号線及び前記映像信号線に重畳して配置され、共通信号線を兼ねることを特徴とする請求項7乃至9のうちいずれかに記載の液晶表示装置。

【請求項 13】前記共通電極が兼ねる共通信号線は、前記画素電極と少なくともその端面が重畳していることを特徴とする請求項10乃至12のうちいずれかに記載の液晶表示装置。

【請求項 14】前記共通電極が兼ねる共通信号線が透明導電体であり、すくなくとも前記アクティブ素子上に遮光層を有することを特徴とする請求項10乃至13のうちいずれかに記載の液晶表示装置。

【請求項 15】前記共通電極が兼ねる共通信号線が金属であることを特徴とする請求項10乃至13のうちいずれかに記載の液晶表示装置。

【請求項 16】前記画素電極が透明電極であることを特徴とする請求項7乃至1

5のうちいずれかに記載の液晶表示装置。

【請求項 1 7】第1と第2の透明な基板と、前記第1と第2の基板間に挟まれた液晶層を有し、前記第1の基板は複数の映像信号線、複数の走査信号線、及び前記映像信号線と前記走査信号線に囲まれた領域として形成される複数の画素領域を有し、各画素領域は少なくとも1つのアクティブ素子と画素電極と共通電極とを有し、該画素電極と前記液晶層の間にカラーフィルターを有する液晶表示装置において、

前記共通電極及び画素電極は前記カラーフィルタ層より下層に形成され、前記カラーフィルターは前記画素領域において少なくとも前記画素電極及び前記共通電極の全面に重畳していることを特徴とする液晶表示装置。

【請求項 1 8】前記共通電極は透明導電体であり、前記画素電極の下層に少なくともゲート絶縁膜を介して形成されていることを特徴とする請求項 1 7 記載の液晶表示装置。

【請求項 1 9】前記共通電極が面状であり、前記画素電極が線状領域を有しすることを特徴とする、請求項 1 7 あるいは 1 8 のいずれかに記載の液晶表示装置。

【請求項 2 0】前記走査信号線と同層かつ離間して配置された共通信号線を有し、該共通信号線は前記共通電極と重畳領域を有することを特徴とする請求項 1 7 乃至 1 9 のいずれかに記載の液晶表示装置。

【請求項 2 1】前記走査信号線の延在方向に隣接する画素の前記カラーフィルターの境界が前記映像信号線上に位置づけられていると共に、該境界部と該映像信号線に重畳して前記カラーフィルターと前記液晶層の間に遮光層が形成されていることを特徴とする請求項 1 7 乃至 2 0 のいずれかに記載の液晶表示装置。

【請求項 2 2】第1と第2の透明な基板と、前記第1と第2の基板間に挟まれた液晶層を有し、前記第1と第2の基板の少なくとも一方に形成された共通電極を有し、前記第1の基板は複数の映像信号線、複数の走査信号線、及び前記映像信号線と前記走査信号線に囲まれた領域として形成される複数の画素領域を有し、各画素領域は少なくとも1つのアクティブ素子と画素電極を有し、該画素電極と前記液晶層の間にカラーフィルター層を有する液晶表示装置において、

前記カラーフィルターは前記画素電極と前記共通電極の間に形成され、前記液

晶層の駆動用電界は前記画素電極及び前記共通電極の間に前記液晶層及び前記カラーフィルタの双方を通過する経路にて形成されることを特徴とする液晶表示装置。

【請求項 2 3】前記共通電極は前記カラーフィルタと前記液晶層の間に形成され、該共通電極は線状領域と、前記映像信号線上に重畳して形成された領域とを有し、前記画素電極は前記カラーフィルタ下に形成され、前記画素電極と前記カラーフィルタが接触していることを特徴とする請求項 2 2 記載の液晶表示装置。

【請求項 2 4】前記画素電極と前記カラーフィルタが接触していることを特徴とする請求項 2 3 記載の液晶表示装置。

【請求項 2 5】走査信号線延在方向に隣接する画素間のカラーフィルタの境界は前記映像信号線上に位置づけられていると共に、該境界部で隣接するカラーフィルタ同士が重畳し、かつ該カラーフィルタの上には有機平坦化膜が形成されていることを特徴とする請求項 2 2 乃至 2 4 のいずれかに記載の液晶表示装置。

【請求項 2 6】走査信号線延在方向に隣接する画素間のカラーフィルタの境界は前記映像信号線上に位置づけられていると共に、該境界部で隣接するカラーフィルタ同士が絶縁性の有機透明膜で離間されていることを特徴とする請求項 2 2 乃至 2 4 のいずれかに記載の液晶表示装置。

【請求項 2 7】前記カラーフィルタは映像信号線延在方向に隣接する画素間で一体に形成され、かつ前記アクティブ素子と該カラーフィルタの間には無機絶縁膜が形成されていることを特徴とする、請求項 2 2 乃至 2 4 及び 2 6 のいずれかに記載の液晶表示装置。

【請求項 2 8】前記映像信号線延在方向に隣接する画素間の前記カラーフィルタの境界は前記走査信号線上に位置づけられていると共に、該境界部で隣接するカラーフィルタ同士が絶縁性の有機透明膜で離間されていることを特徴とする請求項 2 2 乃至 2 4 及び 2 6 のいずれかに記載の液晶表示装置。

【請求項 2 9】前記カラーフィルタ上に有機平坦化膜が形成されていることを特徴とする請求項 2 2 乃至 2 4 及び 2 6 乃至 2 8 のうちいずれかに記載の液晶表示装置。

【請求項 3 0】前記カラーフィルタが導電性を有することを特徴とする請求項 2

2乃至24及び26乃至29のうちいずれかに記載の液晶表示装置。

【請求項31】前記導電性の指標としての抵抗率が、10の14乗 $\Omega \text{ cm}$ 以下であることを特徴とする請求項30記載の液晶表示装置。

【請求項32】前記導電性の指標としての抵抗率が、10の10乗 $\Omega \text{ cm}$ 以下であることを特徴とする請求項30記載の液晶表示装置。

【請求項33】前記カラーフィルタがイオン性成分を含有することを特徴とする請求項22乃至24及び26乃至32のうちいずれかに記載の液晶表示装置。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】

本発明は液晶表示装置およびその製造方法に関する。

【0002】

【従来の技術】

TFTを駆動素子として利用する液晶表示装置の基本的構成の一例は、第1の透明基板上にTFT、走査配線、あるいは信号配線を形成、第2の透明基板上にカラーフィルタを形成、第1と第2の透明基板の上記TFTあるいはカラーフィルタ形成面を内側にしてその間隙に液晶が封入された構成となっている。第1の基板上的TFTは各画素領域に配置される。また第2の基板上的カラーフィルタは各画素領域に対して、色の赤(R)、緑(G)、青(B)の領域をストライプ状に配置、各色CFの区切りは金属などのブラックマトリクス構成となっている。このように構成された液晶表示装置の明るさすなわち開口率は第1と第2の基板の位置合わせ精度が悪いと大幅に低下し、この影響は第1の基板上的TFTや走査配線あるいは信号配線間の合わせ精度の悪化の影響より大きい。そのため、第1の基板上にTFT、走査配線、あるいは信号配線などに加えて、従来第2の基板に形成されていたカラーフィルタやブラックマトリクスを、同時に形成する技術、一般にカラーフィルタ・オン・TFTと呼ぶ技術が公開されている。

【0003】

一方、液晶表示装置の視野角を広げる方式として、液晶分子を基板とほぼ水平に保ったまま回転させ、液晶を駆動するための画素電極と共通電極を共に第1の

基板上に形成させ、この2つの電極間に電圧をかけて基板とほぼ水平に近い電界を生じさせるようにしたIPS (In-Plane-Switching) 方式や上記画素電極と共通電極の一方の電極をくし歯形状に加工せず平板状にして、その上部に絶縁膜を介してくし歯状電極を形成するFSS (Fringe-Field-Switching) 方式が提案されている。FSS方式は特開平11-202356号公報に開示されている。

【0004】

また、IPS方式でカラーフィルタ・オン・TFTを実現する方法は、特開平2000-111957号公報等を開示されている。

【0005】

【発明が解決しようとする課題】

しかしながら、特開平2000-111957号公報では液晶層に電界を印加する画素電極をカラーフィルタ層に開口したスルーホールを通じてカラーフィルタ層上部に配置している。このスルーホールは各画素毎に形成されている。しかし発明者らは、実験の結果このスルーホールの目詰まりによる歩留まり低下が大きいという量産性、歩留まりに関する重大な問題を見出すに至った。またIPS表示方式では誘電率が低く、かつその厚さがTFT上の無機絶縁膜の膜厚より厚いカラーフィルタ層による分圧効果のため、特開平2000-111957号公報のようにスルーホールを開けない場合、液晶層に十分な電圧を加えることができず、透過率が低くなるという課題がある。

【0006】

さらに、特開平11-202356号公報では液晶分子を前記第1の基板と水平に回転させるために、第1の基板上にくし歯形状にしない共通電極及びその上に絶縁膜を介してくし歯形状の画素電極を形成する構成を開示しているが、カラーフィルタはこの第1の基板には形成されておらず、カラーフィルタ・オン・TFTに関する問題点を含めた技術開示はない。一方、特開平2000-111957号公報はIPS方式を用いたカラーフィルタ・オン・TFTの1つの方式を開示しているが、断面構造において、画素電極と共通電極の間に透明の絶縁膜を形成することを基本構成として、カラーフィルタCF層を構成する樹脂製の色層

を各画素の指定された配色により、赤（R）、緑（G）、青（B）の所定の厚さで構成し、パターンニングされる。そのため、通常のTFTを形成した後、3回のホト・パターンニング工程を経て、カラーフィルタ層のR、G、Bを形成、続いて、画素電極あるいは共通電極の一方のくし歯電極を形成、その後に透明な絶縁膜を形成、さらに、その上部に画素電極あるいは共通電極のもう一方のくし歯電極を形成することになっており、極めて工程が長いという問題があった。さらに、このような長い工程は、TFTが形成された第1の基板上の露光の位置合わせの機会を増加させ、位置合わせマージンを確保した製造工程を行った場合、カラーフィルタ・オン・TFTの目的である開口率や透過率を上げて明るい液晶表示装置を提供する本来の目的が損なわれる問題がある。

【0007】

本発明の目的は上記課題の解決に有り、その第1の目的は画素毎にスルーホールを形成せずに、第1のガラス基板上に、液晶層を駆動する画素電極、共通電極が配置され、さらに、カラーフィルタ層も内蔵するTFT液晶表示装置を提供することにある。

【0008】

また第2の目的は、簡略な製造方法を用いて、液晶分子を基板に水平に回転させて視野角の広い液晶表示装置を形成する際に第1の基板上にTFTのみならずCFを形成した液晶表示装置およびその製造方法を提供することである。

【0009】

さらに第3の目的は、開口率あるいは透過率が高い液晶表示装置およびその製造方法を提供することである。

【0010】

本発明の更なる目的は本明細書において明らかになるであろう。

【0011】

【課題を解決するための手段】

上記課題を解決するための代表的手段を簡単に説明すると、次のようになる。

【0012】

（手段1）第1と第2の透明な基板と、前記第1と第2の基板間に挟まれた液晶層

を有し、前記第1の基板は複数の映像信号線、複数の走査信号線、及び前記映像信号線と前記走査信号線に囲まれた領域として形成される複数の画素領域を有し、各画素領域は少なくとも1つのアクティブ素子と画素電極を有し、該画素電極と前記液晶層の間にカラーフィルター層を有する液晶表示装置において、走査信号線延在方向に隣接する画素のカラーフィルターの境界が前記映像信号線上に位置づけられていると共に、該境界部と該映像信号線に重畳して前記カラーフィルターと前記液晶層の間に遮光層を形成するものである。

【 0 0 1 3 】

これにより工程の短縮、及び映像信号線上にカラーフィルターの境界を設け、かつ該境界領域を遮光する遮光層を設けることで、位置合わせマージンを低減でき、開口率を向上した液晶表示装置が実現できる。

【 0 0 1 4 】

(手段2) 第1と第2の透明な基板と、前記第1と第2の基板間に挟まれた液晶層を有し、前記第1の基板は複数の映像信号線、複数の走査信号線、及び前記映像信号線と前記走査信号線に囲まれた領域として形成される複数の画素領域を有し、各画素領域は少なくとも1つのアクティブ素子と画素電極と共通電極とを有し、該画素電極と前記液晶層の間にカラーフィルターを有する液晶表示装置において、前記共通電極は前記カラーフィルタより上層に形成され、前記画素電極は前記カラーフィルタより下層に形成され、前記カラーフィルターは前記画素領域において少なくとも前記画素電極全面に重畳して形成するものである。

【 0 0 1 5 】

これにより、画素毎にスルーホールを形成せずに、第1のガラス基板上に液晶層を駆動する画素電極、共通電極が配置し、さらにカラーフィルタ層も内蔵するTFT液晶表示装置を提供できる。

【 0 0 1 6 】

(手段3) 第1と第2の透明な基板と、前記第1と第2の基板間に挟まれた液晶層を有し、前記第1の基板は複数の映像信号線、複数の走査信号線、及び前記映像信号線と前記走査信号線に囲まれた領域として形成される複数の画素領域を有し、各画素領域は少なくとも1つのアクティブ素子と画素電極と共通電極とを有し

、該画素電極と前記液晶層の間にカラーフィルターを有する液晶表示装置において、前記共通電極及び画素電極は前記カラーフィルタ層より下層に形成され、前記カラーフィルターは前記画素領域において少なくとも前記画素電極及び前記共通電極の全面に重畳して形成するものである。

【 0 0 1 7 】

本手段でも、手段 2 と同様に画素毎にスルーホールを形成せずに、第 1 のガラス基板上に液晶層を駆動する画素電極、共通電極を配置し、さらにカラーフィルタ層も内蔵する T F T 液晶表示装置を提供できる。

【 0 0 1 8 】

(手段 4) 第 1 と第 2 の透明な基板と、前記第 1 と第 2 の基板間に挟まれた液晶層を有し、前記第 1 と第 2 の基板の少なくとも一方に形成された共通電極を有し、前記第 1 の基板は複数の映像信号線、複数の走査信号線、及び前記映像信号線と前記走査信号線に囲まれた領域として形成される複数の画素領域を有し、各画素領域は少なくとも 1 つのアクティブ素子と画素電極を有し、該画素電極と前記液晶層の間にカラーフィルター層を有する液晶表示装置において、前記カラーフィルターは前記画素電極と前記共通電極の間に形成され、前記液晶層の駆動用電界は前記画素電極及び前記共通電極の間に前記液晶層及び前記カラーフィルタの双方を通過する経路にて形成される構成とするものである。

【 0 0 1 9 】

このように配置にすることにより、カラーフィルタ層の各画素にスルーホールを形成しなくても、カラーフィルタ層と第 2 の基板に挟まれた液晶層に駆動用電界が印加される。カラーフィルターにスルーホールを設けないので、各層レイヤ間の合わせ精度が向上するので、開口率が向上し明るい T F T 液晶表示装置が実現できる。

【 0 0 2 0 】

さらに本発明の手段の例を説明すると次のようになる。

【 0 0 2 1 】

液晶層により大きい電界を印加するためには、前記カラーフィルタ層に形成された画素あるいは共通電極を平面的にくし歯形状として、そのカラーフィルタ下

部の共通電極あるいは画素電極を矩形にして、少なくとも上記くし歯電極の端部が下部の矩形電極と重畳し、共通電極と画素電極間の電界強度が上記のように共通電極と画素電極の間に挟む絶縁膜の膜厚で規定するようにすれば良い。また、画素あるいは共通電極を平面的にくし歯形状として、そのカラーフィルタ下部の共通電極あるいは画素電極を矩形にして、少なくとも上記くし歯電極の端部が下部の矩形電極と重畳し、共通電極と画素電極間の電界強度が上記のように共通電極と画素電極の間に挟む絶縁膜の膜厚で規定するようにして、その上部にカラーフィルタ層を形成させても良い。

【 0 0 2 2 】

本発明の他の目的を達成する液晶表示装置は、カラーフィルタ層を少なくとも2層以上重ねてTFTの遮光膜として働きを持たせて、工程を簡略化する。

【 0 0 2 3 】

本発明の他の目的を達成する液晶表示装置は、カラーフィルタ層は隣り合うドレイン配線にそって分離して重ならないようにするか、各画素毎に分離することにより、透過率の高いカラーフィルタを使用できるとともに、カラーフィルタ層自身を電極として利用できるのも、駆動電圧が低く、明るいTFT液晶表示装置が提供できる。

【 0 0 2 4 】

本発明の更なる手段、効果は請求項を含む本明細書において明らかになるであろう。

【 0 0 2 5 】

【発明の実施の形態】

以下、本発明の実施の形態を図により説明する。なお、以下の実施例で、半導体膜はアモルファスシリコン(a-Si)、透明導電膜はITOを代表させたが、これは多結晶シリコンや巨大結晶シリコン、単結晶シリコンでもよい。また他の透明導電膜であるインジウム亜鉛酸化物(IZO)、 In_2O_3 、 SnO_2 、 ZnO 、それらの混合物もしくはInを含む導電性酸化物を用いても良い。また、TFTの配線に関する呼称としては、走査配線をゲート配線、映像信号配線をドレイン配線とする。また、TFTのソース、ドレイン電極は、ドレイン配線

側に接続された T F T 部分の電極をドレイン電極、T F T のチャネル長領域を挟んで画素電極側をソース電極と呼ぶ。

【 0 0 2 6 】

〔実施例 1〕

図 1、図 2 は、実施例 1 に係わる方式の液晶表示装置の画素部の構造を示す。
図 1 は図 2 の A - A' 線上の断面を示す。

【 0 0 2 7 】

まず、図 1 を用いて説明する。ガラス基板を用いた第 1 の基板 S U B 1 上には、M o や C r あるいは A l よりなるゲート配線（ゲート電極）G L が配置され、このゲート配線 G L を覆うように S i N からなるゲート絶縁膜 G I が形成されている。ゲート配線 G L は走査用駆動電圧が供給される。また、ゲート配線 G L 上にはゲート絶縁膜 G I を介してアモルファスシリコンからなる半導体膜 A S が配置され、薄膜トランジスタ（T F T）のチャネル層として機能するようになっている。また、リンを高濃度にドーピングした半導体層 d 0 を仲介として、M o、C r あるいは A l によりドレイン電極 S D 1、ソース電極 S D 2 が配置され、これらを被覆するように S i N を用いた保護膜 P S V が形成されている。上記ドレイン電極 S D 1 は実体として映像用信号電圧の供給されるドレイン配線 D L の一部を構成している。そして、保護膜 P S V に貫通したスルーホール C N を介してソース電極 S D 2 に接続する I T O などの透明導電膜を用いた画素電極 P X が保護膜 P S V 上に配置されている。

【 0 0 2 8 】

そして本実施例では、前記画素電極 P X 上にカラーフィルタ層 F I L が形成されている。ここで平面的には、画素電極 P X は、1 画素の領域、すなわち、隣り合うドレイン配線 D L、隣り合うゲート配線で区切られた 1 画素領域の内側に矩形になっている。カラーフィルタ F I L は有機材料を用いており、その平面パターンは縦ストライプパターンとなっている。むろんストライプ状に限るものではなく、長方形状、あるいは特に画素配列がいわゆるデルタ配置の場合は正形状でもよい。図 1 に示すように、例えば、緑色のカラーフィルタ層 F I L（G）と赤色のカラーフィルタ層 F I L（R）はドレイン配線 D L 上で色のパターンが区

切られている。

【 0 0 2 9 】

さらに、上記カラーフィルタ層 F I L 上には、遮光膜 B M と共通電極配線 C L 、共通電極 C T が配置されている。図 2 の平面パターンを見ると、遮光膜 B M はドレイン配線 D L 、ゲート配線 G L 上に形成されており、半導体層 A S に表面からの入射光が直接あたらない構造となっている。一方、共通電極配線 C L は同様に、ドレイン配線 D L 及びゲート配線 G L 上に配置された網の目状パターンになっている。その幅は遮光膜 B M をより幅広く、それは下部の画素電極 P X とカラーフィルタ層 F I L を介して重なるパターンとなっている。また、共通電極 C T は共通電極配線 C L の一部となっており、画素領域でくし歯形状部を有する。本実施例では、遮光膜 B M は C r や M o の金属膜、共通電極配線 C L は I T O などの透明導電膜で構成されている。この共通電極及びその間隙のカラーフィルタ F I L 上には配向膜 O R I が形成されており、その表面は配向処理されている。

【 0 0 3 0 】

一方、ガラスよりなる第 2 の基板 S U B 2 にも内側に配向膜 O R I が形成され、その表面はラビング処理されている。そして、第 1 のガラス基板 S U B 1 と第 2 のガラス基板 S U B 2 が、配向膜 O R I 形成面で対向配置され、これらの間に液晶層 L C が配置されている。また第 1 及び第 2 のガラス基板 S U B 1 、 S U B 2 の外側の面には偏光板 P O L が形成されている。なお、前記第 1 の基板 S U B 1 及び第 2 の基板 S U B 2 はガラスに限られるものではなく、プラスチック等の透明基板でも良い。

【 0 0 3 1 】

以上のように形成された T F T 液晶表示装置では、液晶層 L C に電界が掛かっていないときは、液晶層 L C における液晶分子は第 1 のガラス基板 S U B 1 に対してほぼ平行な状態となるホモジニアス配向をしている。但し、初期配向状態を限定するものではない。第 1 のガラス基板 S U B 1 に形成された共通電極 C T 及び共通電極配線 C L と画素電極 P X 間に電圧差を加えると電界が発生し、閾値電界以上の値では液晶分子が回転し、透過率が制御される。液晶層にかかる電気力線は共通電極 C T から液晶層 L C 及びカラーフィルタ層 F I L を通り画素電極 P

Xに至る。本構造では、基板に対する横方向の電界成分を多く含むので液晶分子が基板に対して回転する成分が支配的になり、視野角が広い液晶表示装置が得られる。

【 0 0 3 2 】

また、画素領域内のくし歯状の共通電極CTと画素電極PXはカラーフィルタ層FILを挟んで重なっており、液晶層LCに印加される最大電界はカラーフィルタ層FILの厚さで規定される。カラーフィルタ層は1～2 μ mの樹脂層で形成されている。本方式は、第1ガラス基板SUB1上の平面的な寸法で画素電極PXと共通電極CT間の最大電界を規定する、例えば、特開平2000-111957号公報のIPS方式の液晶表示装置に比べて、駆動電圧を小さくできる。また、上記公報は画素カラーフィルタ上にさらに透明絶縁膜を形成し、これを挟むように画素電極と共通電極を配置しており、この透明絶縁膜の成膜とそこに形成されるパターンニングの分だけ、本実施例は工程を簡略できると共に、層間の合わせ回数を削減できるので開口率を向上し、明るい液晶表示が提供できる。

【 0 0 3 3 】

次に、製造方法の一例について説明する。まず、図3(a)に示すように、Cr、Mo、あるいはAlとMoの積層膜を成膜して、これをホトリソグラフィおよびエッチング技術によりパターンニングすることにより、第1のガラス基板SUB1上にゲート配線GLを形成する。

【 0 0 3 4 】

次に、図3(b)に示すように、ゲート配線GLを含む第1のガラス基板SUB1上にSiNからなるゲート絶縁膜GIを形成し、これを介してゲート配線GL上にアモルファスシリコンからなる半導体膜AS、高濃度半導体膜dOを形成する。この半導体膜ASとリンを添加したn型高濃度半導体膜dOは、ゲート絶縁膜GI、半導体膜AS、高濃度半導体膜dOを連続的に成膜し、ホトリソグラフィおよびエッチング技術により高濃度半導体膜dOおよび半導体膜ASパターンニングすることにより形成される。

【 0 0 3 5 】

次に、図3(c)に示すようにドレイン電極SD1、ソース電極SD2を高濃

度半導体膜d0とのパターンと一部重なるように形成する。その後、上記ドレイン電極SD1、ソース電極SD2をマスクとして、ドライエッチングにより高濃度半導体層d0を除去して、TFTのチャンネル領域を形成する。ドレイン配線DLはドレイン電極SD1と同一工程、材料で形成される。

【0036】

次に、図4(a)に示すように、ドレイン電極SD1、ソース電極SD2、半導体膜AS、ドレイン配線DLを覆うように、ゲート絶縁膜GI上にSiNを用いて保護膜PSVを形成する。引き続き、ホトリソグラフィおよびエッチングにより、ソース電極SD2上に保護膜PSVのコンタクトホールCNを開口する。次に、図4(b)に示すように、保護膜PSV上にITOからなる透明導電膜を用いた画素電極PXを形成する。この画素電極PXは平面的にはほぼ矩形であり、コンタクトホールCNを介してソース電極SD1に接続される。

【0037】

次に、図5(a)に示すように、保護膜PSV及び画素電極PX上にカラーフィルタ層FILを形成する。カラーフィルタ層FILは、例えば、赤色(R)、緑色(G)、もしくは青色(B)の染料あるいは顔料を含んだ樹脂膜から形成される。これは、例えば、赤色などの所望の光学特性が得られる顔料を、アクリルをベースにした感光性樹脂中に分散した顔料分散レジストを用いる。まず、顔料分散レジストを画素電極PX、保護膜PSV上に塗布し、これをホトマスクを用いて隣合うドレイン配線DL上にパターンエッジが来るように、露光、現像し形成する。これらの工程を、色数、例えば、赤(R)、青(B)、緑(G)の3色分3回繰り返すことで、カラーフィルタ層FILが形成できる。

【0038】

次に、図5(b)に示すように、CrあるいはMoの遮光膜BMを形成し、最終的に、ITOを用いた透明導電膜で共通電極配線CLおよび共通電極CTを形成する。共通電極配線CLはドレイン配線DLをカラーフィルタFILを介して蓋をするように形成する。共通電極CTはくし歯状でカラーフィルタFILを介して下部の画素電極PXと重なっている。

【0039】

なお、上記遮光膜BMは金属膜で形成しているが、この場合CLと合わせて共通電位をより低抵抗化に伝達できるという利点もある。また樹脂膜でも良く、この場合CLとDL間の容量を更に低減できるという効果も有る。また用途によっては省略も可能であり、これにより工程が簡略化され、歩留まりが向上するとともに安価な液晶表示装置が提供できる。特に半導体膜ASを多結晶シリコンもしくは巨大結晶シリコンあるいはシリコン多結晶の結晶粒界同士が隣接した、連続粒界シリコン (Continuous Grain Silicon: CGS) を用いた場合は、光照射で発生するTFTがオフ状態でのドレイン電極SD1とソース電極SD2間のリーク電流を小さくできるので、この遮光膜BMは容易に除去できる。

【 0 0 4 0 】

以上のように本実施例では、カラーフィルタFIL上の共通電極CTおよび共通電極配線CLからの電気力線が図1の液晶層LCを経由、カラーフィルタ層FILを経てその下部の画素電極PXに至る。この電気力線で決まる電界で液晶層LC中の液晶分子が回転し透過率が制御される。さらに、本実施例の画素領域は、図1及び図2に示すように、カラーフィルタ層FILにスルーホールを形成していない。これは、第1のガラス基板SUB1上にカラーフィルタを形成した、特開平2000-111957号公報で開示された、IPS方式の液晶表示装置と大きな違いである。これにより、樹脂で形成したカラーフィルタFILの各画素にコンタクトホールを形成する場合に生じるコンタクト不良による歩留まり低下、及び画素毎でのコンタクト抵抗の違いにより画素毎での輝度むらの発生根本的に解消することが出来た。これにより、第1のガラス基板SUB1上に、画素電極PX、共通電極CTさらにカラーフィルタ層FILを形成した広視野角の液晶表示装置として、歩留まり品質が高く、画素毎の輝度むらを解消した液晶表示装置を実現した。

【 0 0 4 1 】

なお、本実施例ではTFTに関して記述したが、MIMでもよい。

【 0 0 4 2 】

また本実施例では画素部の構成につき説明したものであるが、周辺部には走査

信号駆動回路、映像信号駆動回路、制御回路など種々の回路が設けられ、それにより液晶表示装置が駆動されることは言うまでもない。むしろこれら回路の一部あるいは全部が第1の基板SUB1上に多結晶シリコンもしくは巨大結晶シリコンあるいはシリコン多結晶の結晶粒界同士が隣接した、連続粒界シリコンCGSを用いたアクティブ素子により構成されていても良い。

【0043】

また配線もしくは電極に用いる金属材料は、上記説明中で示した材料以外にTa, Wなどでも良い。

【0044】

また透過型、もしくはフロントライト方式の液晶表示装置として構成した場合には、一方の偏光板の背面にはバックライトユニットが備えられていることは言うまでもない。

【0045】

〔実施例2〕

本実施例と実施例1の構造上の違いを図6及び図7を用いて説明する。なお、図6は図7のB-B'切断線の断面を示している。

【0046】

本実施例の液晶表示装置では、第1のガラス基板SUB1上にはゲート配線GL、共通電極配線CLが配置され、さらにITOなどの透明導電膜で形成した共通電極CTが、図7に示すように、共通電極配線CLと重ねて接続をとる配置となっている。共通電極CTは平面的には、ゲート配線GLやドレイン配線DLと重ならないようにしながら、矩形形状をなす。これらの、第1のガラス基板SUB1の電極、配線を覆うようにゲート絶縁膜GIが被覆されている。ゲート絶縁膜GI上には半導体層AS、ドレイン電極SD1、ソース電極SD2が形成されており、上記電極と半導体層ASの接続はリンをドーブしたn型の高濃度半導体層d0が形成されている。上記、ソース電極SD2、ドレイン電極SD1は実施例1と同様な金属膜で形成されている。ドレイン電極SD1はドレイン配線DLの一部を構成している。

【0047】

ソース電極SD2に接続された画素電極PXはITOなどの透明導電膜で形成されており、それは画素領域内でくし歯形状になっており、このくし歯は、下部のゲート絶縁膜GIを介して共通電極CTと重なっている。PXは線状領域を有すればよく、その両端が相互に接続されていても良い。そして、その画素電極PX上にはSiNを用いた保護膜PSVが被覆されている。該保護膜PSV上には、カラーフィルタ層FILが形成されている。その上部には、TFT部分の遮光とドレイン配線DL周辺のブラックマトリクスを兼ねる遮光膜BMが形成されている。その上部には配向膜ORIが形成され、第2のガラス基板SUB2の内側に形成された配向膜ORIと同様に配向処理されている。

【0048】

以上のように本実施例では、保護膜PSV下部にある画素電極PXから延びた電気力線が、保護膜PSV、カラーフィルタ層FIL、液晶層LCを経て、さらに、再度、下部に降下し、カラーフィルタ層FIL、保護膜PSV、画素電極PXの間隙のゲート絶縁膜GIを経て、共通電極CTに至る。ここで、用いた液晶の誘電異方性はとくに規定はしない。但し本構造では正の誘電率異方性を有する材料の方が駆動電圧を下げる事が可能であり、より望ましい。

【0049】

本実施例は実施例1と同様に、この樹脂で形成したカラーフィルタFILの各画素にコンタクトホールを形成されておらず、従来の公知例に比べて歩留まりを高くできる特徴を有する。さらに本実施例は、実施例1に比べて点欠陥を低減できるという大きな利点をもつ。以下に、その理由を説明する。

【0050】

有機材料と無機材料の間の固着は、有機材料同士あるいは無機材料同士より難しいことが知られている。しかし実施例1ではカラーフィルタFIL上に導電性の金属あるいは透明導電体による無機材料である共通電極CTを形成する必要がある。このため、この共通電極がFILから製造過程においてはがれやすく、点欠陥が生じ易い構造となっている。さらに、共通電極CTは櫛歯状あるいは線状に加工されているため、その幅も狭く、さらに剥がれやすいものとなっている。FIL状の構成物が剥がれた場合、それが電極であれば該領域では光の制御が不

能になり、また光そのものは制御可能であっても液晶層のギャップを変動させ、輝度むらにつながる。一方本実施例では、F I L 上には遮光層を形成する。この遮光層は、一例として樹脂で形成する。この場合遮光層 B M とカラーフィルタ F I L は有機材料同士であるので、相対的に剥がれ難い構成となる。また遮光層 B M を金属材料で形成した場合、遮光層であるので実施例 1 の C T より幅広で形成できるため、F I L との接触面積を増加できるため実施例 1 よりも剥がれ難い構造を実現できる。すなわち、本実施例では遮光層 B M が樹脂、金属いずれの場合でも、実施例 1 に比べ F I L 上の構成層を剥がれ難いものとでき、歩留まりを向上できる。

【 0 0 5 1 】

〔実施例 3〕

図 8 に断面図を示す。第 1 のガラス基板 S U B 1 上に走査電圧を駆動するゲート配線 G L、映像信号電圧を供給するドレイン配線 D L 及びその一部をなすドレイン電極 S D 1、ソース電極 S D 2、S i N で形成されたゲート絶縁膜 G I、保護膜 P S V、保護膜 P S V 上配置されソース電極 S D 2 に接続された画素電極 P X が形成されている。画素電極 P X までの構造、製造工程は、実施例 1 と同じである。

【 0 0 5 2 】

本実施例と実施例 1 の違いは、画素内の画素電極 P X より上部の構造とそれに対応する工程である。カラーフィルタ層 F I L が、T F T の半導体層 A S で、単一の色に対するカラーフィルタ層 F I L (R) に対して、隣の画素のカラーフィルタ層 F I L (G) が重ねてある。このように、少なくとも、2 層以上のカラーフィルタ F I L を重ねることにより、第 2 のガラス基板 S U B 2 側から入射する光からの遮光膜効果が高まる。図 6 では 2 層重ねたが、これに他のもう 1 つの色である青のカラーフィルタ F I L (B) を重ねるとさらにその遮光効果が高くなる。

【 0 0 5 3 】

本実施例は、画素の一部で、カラーフィルタ層 F I L の色層を 2 層あるいは 3 層平面的に重ねることにより、これを T F T 部分の遮光膜あるいは画素間の区切

りのブラックマトリクスの少なくとも一部として適用している。これにより、実施例 1 に比べて、別途の成膜、パターニングで形成した遮光膜 BM が省略できる。カラーフィルタ層 FIL は、例えば、赤色 (R)、緑色 (G)、もしくは青色 (B) の染料あるいは顔料を含んだ樹脂膜から形成される。これは、例えば、赤色などの所望の光学特性が得られる顔料が、アクリルをベースにした感光性樹脂中に分散された顔料分散レジストを用いる。まず、顔料分散レジストを画素電極 PX、保護膜 PSV 上に塗布し、これをホトマスクを用いて露光、現像し形成する。これらの工程を、色数、例えば、赤 (R)、青 (B)、緑 (G) の 3 色分 3 回繰り返すことで、カラーフィルタ層 FIL が形成できる。

【 0 0 5 4 】

本実施例では、カラーフィルタ層 FIL の上部に透明な絶縁膜材料からなるオーバコート層 OC を形成する。このオーバコート層 OC は、例えば、アクリル樹脂などの熱硬化樹脂を用いる。また、光硬化性の透明な樹脂を用いても良い。その上に、CL、CT を形成した。このオーバコート層 OC はカラーフィルタ層 FIL が部分的に重なりその段差による配向膜 ORI のラビング工程で発生する不良を低減できる平坦化効果がある。これにより、隣合うドレイン配線 DL 間隔、隣合うゲート配線 GL 間隔が小さくなる高精細、一例としてドレイン配線 DL の間隔が $80\mu\text{m}$ 以下の TFT 液晶表示装置において、配向処理、特にラビング処理による場合に伴う不良が実施例 1 に比べて低減した。

【 0 0 5 5 】

また本実施例では、カラーフィルタ FIL 上の共通電極 CT および共通電極配線 CL から液晶層 LC を経由、カラーフィルタ層 FIL、オーバコート層 OC を経てその下部の画素電極 PX に至る電気力線で決まる電界により、液晶層 LC 中の液晶分子が回転し透過率が制御される。

【 0 0 5 6 】

〔実施例 4〕

図 9、図 10 は、本発明の実施例 4 に係わる方式の液晶表示装置を示す。

【 0 0 5 7 】

図 9 は、図 10 の 1 画素の平面図の C-C' 線上の断面を示す。第 1 のガラス

基板SUB1上に走査電圧を駆動するゲート配線GL、映像信号電圧を供給するドレイン配線DL及びその一部をなすドレイン電極SD1、ソース電極SD2、SiNで形成されたゲート絶縁膜GI、保護膜PSV、保護膜PSV上配置されソース電極SD2に接続された画素電極PXが形成されている。画素電極PXまでの構造、製造工程は、実施例1と同じである。

【0058】

上記保護膜PSV上にカラーフィルタ層FILを形成する。本実施例ではカラーフィルタ層FILの平面パターンが実施例1及び2と大きく異なっている。カラーフィルタ層FILは隣り合うドレイン配線DL付近で境界を持つが、隣り合うカラーフィルタ層FILは互いに分離した領域を有する。図9の断面図では、赤色のカラーフィルタ層FIL(R)と緑色のカラーフィルタ層FIL(G)はドレイン配線DL上近傍で互いに重なったり、接触していない領域が有ることを示している。

【0059】

一方、隣り合うカラーフィルタ層FILの間隙は大きな段差を持つので、その上部より透明な絶縁膜材料からなるオーバコート層OCを形成する。このオーバコート層OCは、例えば、アクリル樹脂などの熱硬化樹脂を用いる。また、光硬化性の透明な樹脂を用いても良い。このオーバコート層OCはカラーフィルタ層FILが部分的に重なりその段差による配向膜ORIの塗布不良、さらには配向不良を低減する平坦化効果がある。

【0060】

その上部には、液晶層LCを駆動する共通電極CT及び共通電極配線CLをがくし歯形状に配置されている。共通電極CTはITOなどの透明導電膜で形成する。但し、第1～第3の実施例でも同じであるが、この共通電極CT及び共通電極配線CLともにCrやMoのような金属膜を用いても良い。この場合は、透過率は低下するが、ITOより抵抗が低く、さらに遮光膜の役割も果すので特別な遮光膜BMを設ける必要がなく、より大画面のTFT液晶表示装置が提供できる。

【0061】

本実施例の最大の特徴は、上記のように、各画素のカラーフィルタ層が、隣り合うドレイン配線DLに沿って、互いに重ならないように分離されている、あるいは、さらに隣り合うゲート配線に沿って、1画素、1画素分離している点にある。これは、以下の性能向上を実現するためである。カラーフィルタの色を決めるカラーレジストにとって、高色純度と高透過率はトレードオフの関係に有る。このようなトレードオフを両立する材料として、発明者らは導電性を有する材料が有望であることを見出した。また別の有望な材料として、イオン性成分が含まれる材料が有望であることを見出した。しかし、実際の製品構造に準じ試作を行うと、クロストークの悪化、駆動電圧の上昇、信頼性の不良など予期しない新たな現象が生じた。これらを詳細に解析した結果、その原因は以下のものであるとの解釈に至った。

【0062】

すなわち、カラーフィルタFILにこれら材料を用い、かつ隣り合う画素間のカラーフィルタ層FILが重なっていると、導電性が高い材料では、画素電極PXの電位が隣の画素にリークしてしまい、これによりクロストークの悪化や実効電圧の低下、すなわち駆動電圧の上昇が生じたものと判明した。

【0063】

また、イオン性成分を含む場合には、接触したカラーフィルタFIL同士でイオンの交換が生じ、カラーフィルタFILに退色現象が生じることが判明した。そしてこの退色現象は時間と共に進行する信頼性上の問題を示すことも判明した。そして導電性を有しイオン性成分を有する場合には、液晶表示装置の実際の駆動、すなわち通電によりイオンの交換が加速され、急速に退色が起きることが判明した。

【0064】

そこで発明者らは、導電性を有する、あるいはイオン性成分を有する、もしくは導電性を有しかつイオン性成分を有するカラーフィルタを適用するために、図9に断面図、図10に平面図として示す構造を考案した。すなわち各画素毎にカラーフィルタFILを分離して、さらに透明性のオーバコート膜OCでカラーフィルタ間を分離したものである。またさらに該オーバコート膜OCを、カラーフ

ィルター F I L と該カラーフィルタ上に形成された電極もしくは導電材料、例えば共通電極 C T との間に設けたものである。

【 0 0 6 5 】

前者の手法では、カラーフィルターが導電性を有する場合、画素間でカラーフィルターの短絡が防止できるためクロストークの悪化、及び駆動電圧の上昇を防止することが出来る。またカラーフィルターがイオン性成分を有する場合、カラーフィルター間のイオン交換を防止でき、カラーフィルタの退色を防止することができる。

【 0 0 6 6 】

後者の手法では、カラーフィルターが導電性を有する場合、画素電極 P X と共通電極 C L の短絡を防止することができる。またカラーフィルターがイオン性成分を有する場合には、カラーフィルタ中のイオン性成分が液晶層に溶け出し液晶層を汚染することを防止できるとともに、液晶層とカラーフィルター間のイオン交換を抑制できるため、やはりカラーフィルターの退色を防止できる。

【 0 0 6 7 】

また図 1 0 ではゲート配線 G L 間は分離せず、ドレイン配線 D L に沿ったカラーフィルタを重ねないようにしているが、該構造でも一定の効果を実現できる。これはゲート配線 G L の幅はドレイン配線 D L より幅が広く、映像信号線延在方向に隣接する画素電極間の距離を、走査信号線延在方向に隣接する画素電極間の距離より大きく保てるため、画素電極間のリークを低減できるからである。なお、T F T 上には図 9 に示すように保護膜を形成している。これは、カラーフィルタ F I L によるソースドレイン間の短絡を防止する機能も果たしている。

【 0 0 6 8 】

また本実施例では共通電極 C L が画素電極 P X と同じ基板上に形成されている場合を中心に説明したが、本実施例の効果は、共通電極 C L が画素電極 P X と対向する基板上に形成されている場合も同様であり、本実施例に含むものである。

【 0 0 6 9 】

カラーフィルタ F I L は走査信号線延在方向、映像信号線延在方向の双方で各画素間で分離してもよく、その場合には映像信号線延在方向に隣接する画素間の

画素電極同士も完全に分離できるため、より確実に本実施例の効果を実現できる。

【0070】

またカラーフィルターFILが導電性の場合、画素電極PXの電位はカラーフィルター層FILの導電性によりFILの表面側に伝わり、画素電極PXの電位がより液晶層LC側に到達するので、駆動電圧の低いTF T液晶表示装置が提供できるという新たな効果が実現できた。またこの際に、カラーフィルターの導電率を示す抵抗率は、 10 の 14 乗 $\Omega \cdot \text{cm}$ 以下であれば電圧低下の効果が生じ得る。さらに駆動電圧の低下を図るには、 10 の 10 乗 $\Omega \cdot \text{cm}$ 以下であることが望ましい。むしろ低ければ低いほど駆動電圧低下の効果が強まることは言うまでもないが、低抵抗化を図りすぎると光透過率が低下する傾向が有るため、 10 の 3 乗 $\Omega \cdot \text{cm}$ から 10 の 10 乗 $\Omega \cdot \text{cm}$ の範囲にあることが最も望ましい。

【0071】

また本実施例の構成の液晶表示装置では、液晶層にかかる駆動用電界がカラーフィルター層を通過する構成となる。従来の方式、例えばカラーフィルタをTF Tと異なる基板上に設ける方式では、その一例では画素電極がTF T基板上に有り、共通電極がカラーフィルタ基板のカラーフィルタ上に有り、画素電極と共通電極間に駆動用電界を生じせしめる縦電界方式がある。この方式では、液晶層にかかる駆動用電界は、カラーフィルター層を通過しない。

【0072】

またいわゆる横電界方式では、画素電極と共通電極の双方がTF T基板上に有り、該電極間で駆動用電界を形成するため、やはり液晶層にかかる駆動用電界はカラーフィルター層を通過しない。さらにカラーフィルターをTF T基板に設けた方式においても、従来知られる方式はカラーフィルター上に画素電極を設け、対向基板上に共通電極を設け、この間で液晶層にかかる駆動用電界を形成するものであり、やはり液晶層にかかる駆動用電界はカラーフィルター層を通過しない。しかし、本実施例では、画素電極と共通電極の間にカラーフィルター層を設け、該カラーフィルター層を通過して液晶層に駆動用電界を形成するものである。

【0073】

したがって、カラーフィルター層が本実施例のようにイオン性不純物を有する場合、あるいは導電性を有する場合、もしくは何らかの汚染性不純物、一例として金属イオン、あるいは有機溶媒等を含む場合には、該液晶層とカラーフィルターの反応が、前記カラーフィルターを通過する駆動用電界により加速されるため、液晶層の汚染が加速されると言う新たな課題も見出すに至っている。

【 0 0 7 4 】

したがって、液晶表示装置の信頼性を確保し、液晶層の汚染を防止するという観点から、画素電極と共通電極の間にカラーフィルター層を設け、該カラーフィルター層を通過して液晶層に駆動用電界を形成する方式では、カラーフィルターと液晶層の間に汚染防止用の保護膜を形成することが極めて望ましい。またこの保護膜が有機膜である場合には、平坦化効果も合わせて実現できるためさらに望ましい。

【 0 0 7 5 】

以上詳述したように、本実施例の構成によりカラーフィルターが T F T 基板上に配置され、かつ高色純度で明るい T F T 液晶表示装置が実現できる。

【 0 0 7 6 】

また本発明は技術思想、効果を含め実施例 1 から実施例 4 の実施形態に限定されるものではなく、請求項を含む明細書中に開示の技術思想による構成、効果は本発明の範疇に全て含むものである。

【 0 0 7 7 】

【発明の効果】

本発明の効果の代表的な例は以下のようになる。すなわち、画素毎にカラーフィルターにスルーホールを形成せずに、第 1 のガラス基板上に液晶層を駆動する画素電極、共通電極が配置され、さらにカラーフィルタ層も内蔵する T F T 液晶表示装置を提供できる。

【 0 0 7 8 】

さらに簡略な製造方法を用いて、液晶分子を基板に水平に回転させて視野角の広い液晶表示装置を形成する際に第 1 の基板上に T F T のみならず C F を形成させた液晶表示装置およびその製造方法を提供できる。

【 0 0 7 9 】

さらに開口率あるいは透過率が高い液晶表示装置およびその製造方法を提供できる。

【 0 0 8 0 】

さらに視野角が広く、明るい T F T 表示装置を提供できる。

【図面の簡単な説明】

【図 1】 本発明の液晶表示装置の一実施例の画素の断面図である。

【図 2】 本発明の液晶表示装置の一実施例の画素の平面図である。

【図 3】 本発明の液晶表示装置の一実施例の製造方法の説明図である。

【図 4】 本発明の液晶表示装置の一実施例の製造方法の説明図である。

【図 5】 本発明の液晶表示装置の一実施例の製造方法の説明図である。

【図 6】 本発明の液晶表示装置の一実施例の画素の断面図である。

【図 7】 本発明の液晶表示装置の一実施例の画素の平面図である。

【図 8】 本発明の液晶表示装置の一実施例の画素の断面図である。

【図 9】 本発明の液晶表示装置の一実施例の画素の断面図である。

【図 1 0】 本発明の液晶表示装置の一実施例の画素の平面図である。

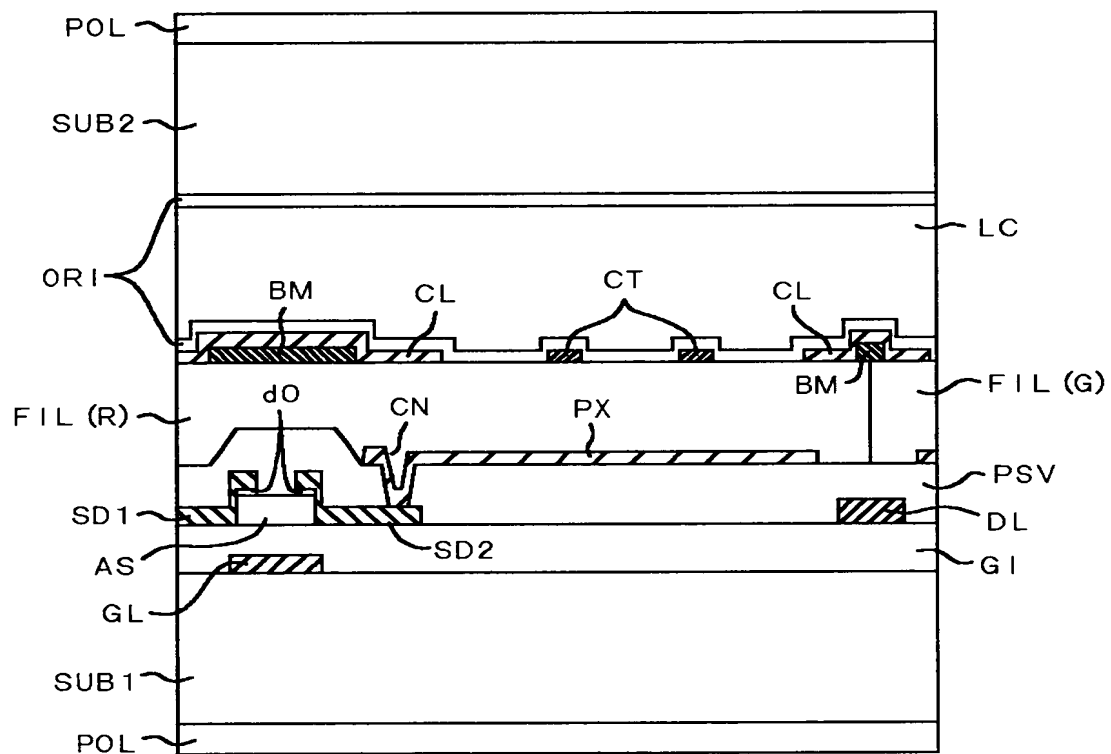
【符号の説明】

A S … 半導体膜、 S U B 1 … 第 1 のガラス基板、 S U B 2 … 第 2 のガラス基板、
S D 1 … ドレイン電極、 S D 2 … ソース電極、 G L … ゲート配線、 D L … ドレイン配線、 C L … 共通電極配線、 C T … 共通電極、 T F T … 薄膜トランジスタ、 G
I … ゲート絶縁膜、 P S V … 保護膜、 P X … 画素電極、 F I L … カラーフィルタ層、 L C … 液晶層、 O R I … 配向膜、 O C … オーバコート膜、 B M … 遮光膜、 P
O L … 偏光板

【書類名】図面

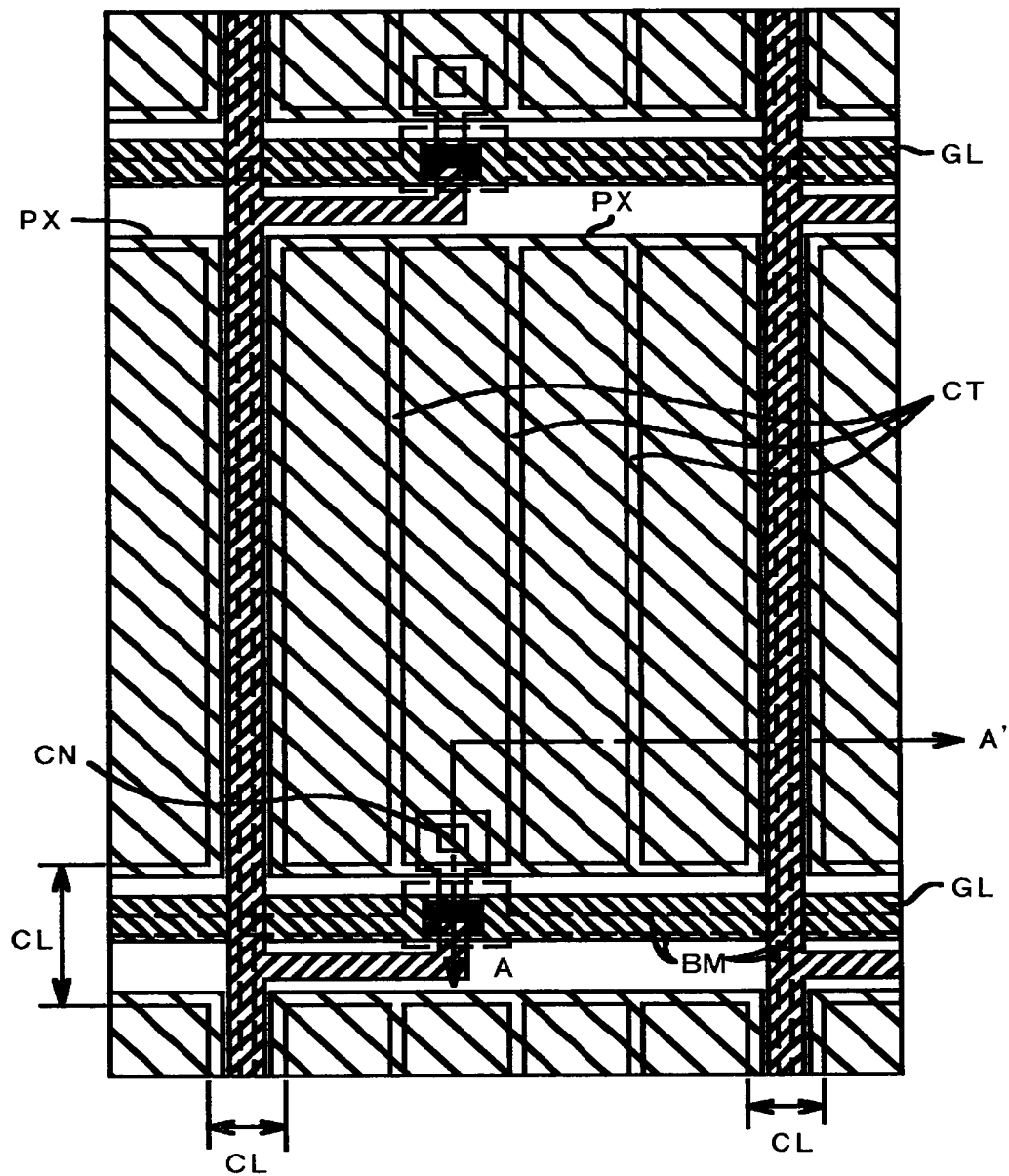
【図 1】

図 1



【図2】

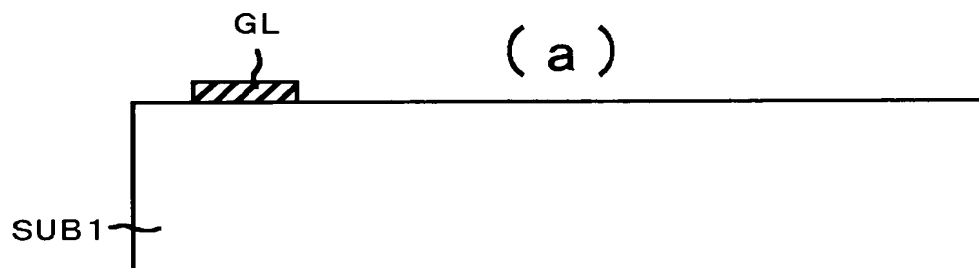
図 2



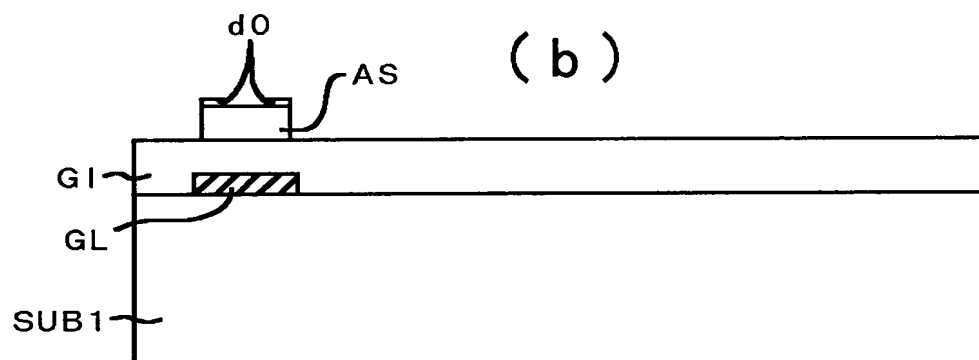
【図3】

図 3

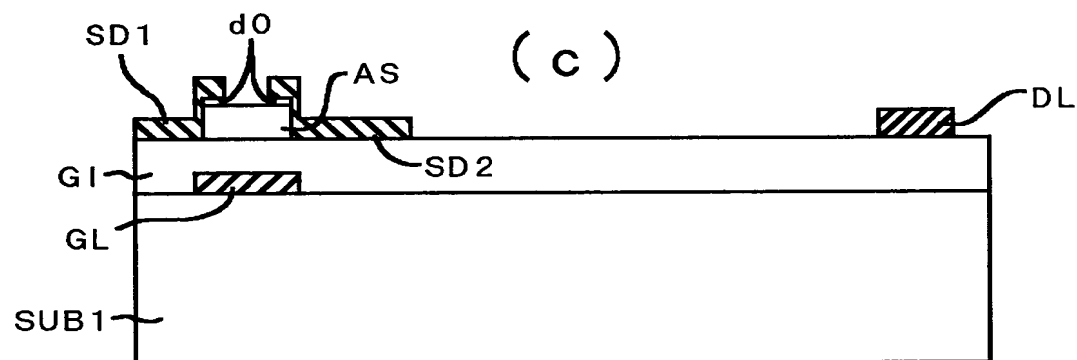
(a)



(b)



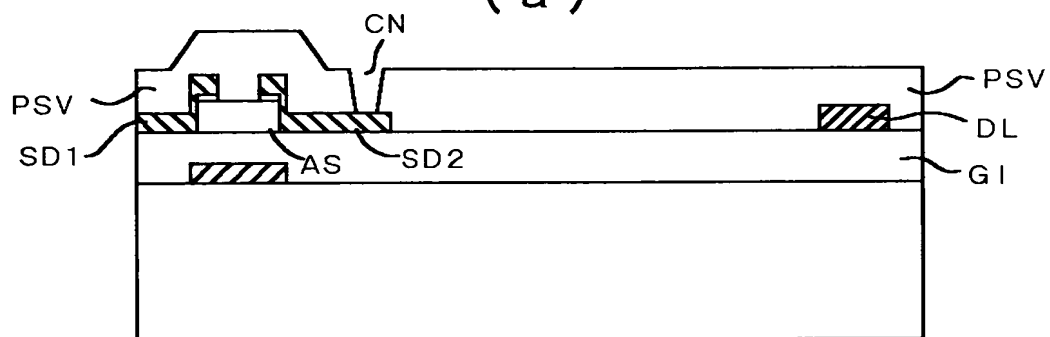
(c)



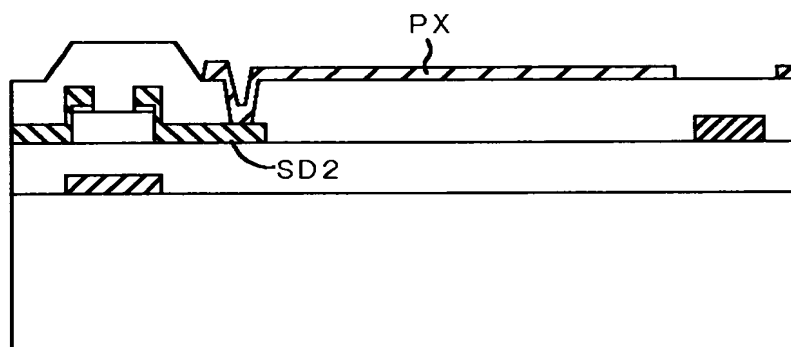
【図4】

図 4

(a)

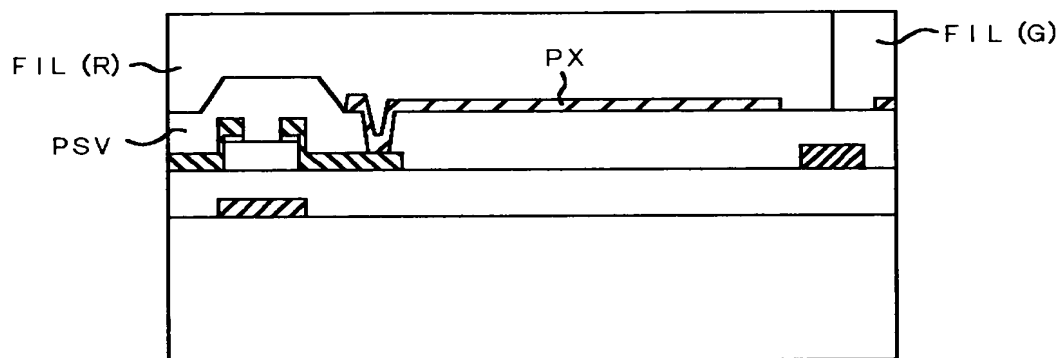


(b)

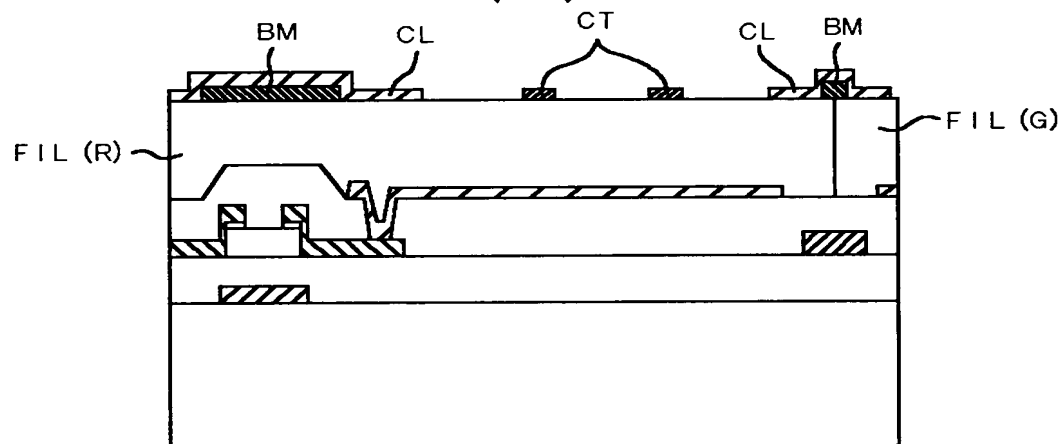


【図5】

図 5
(a)

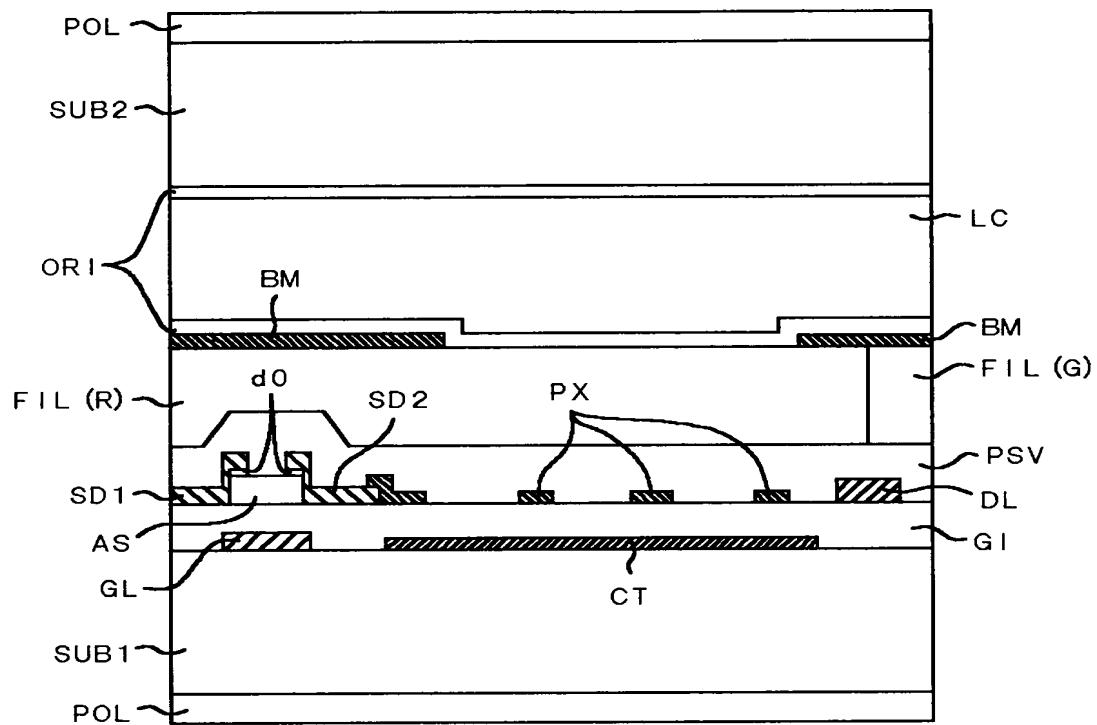


(b)



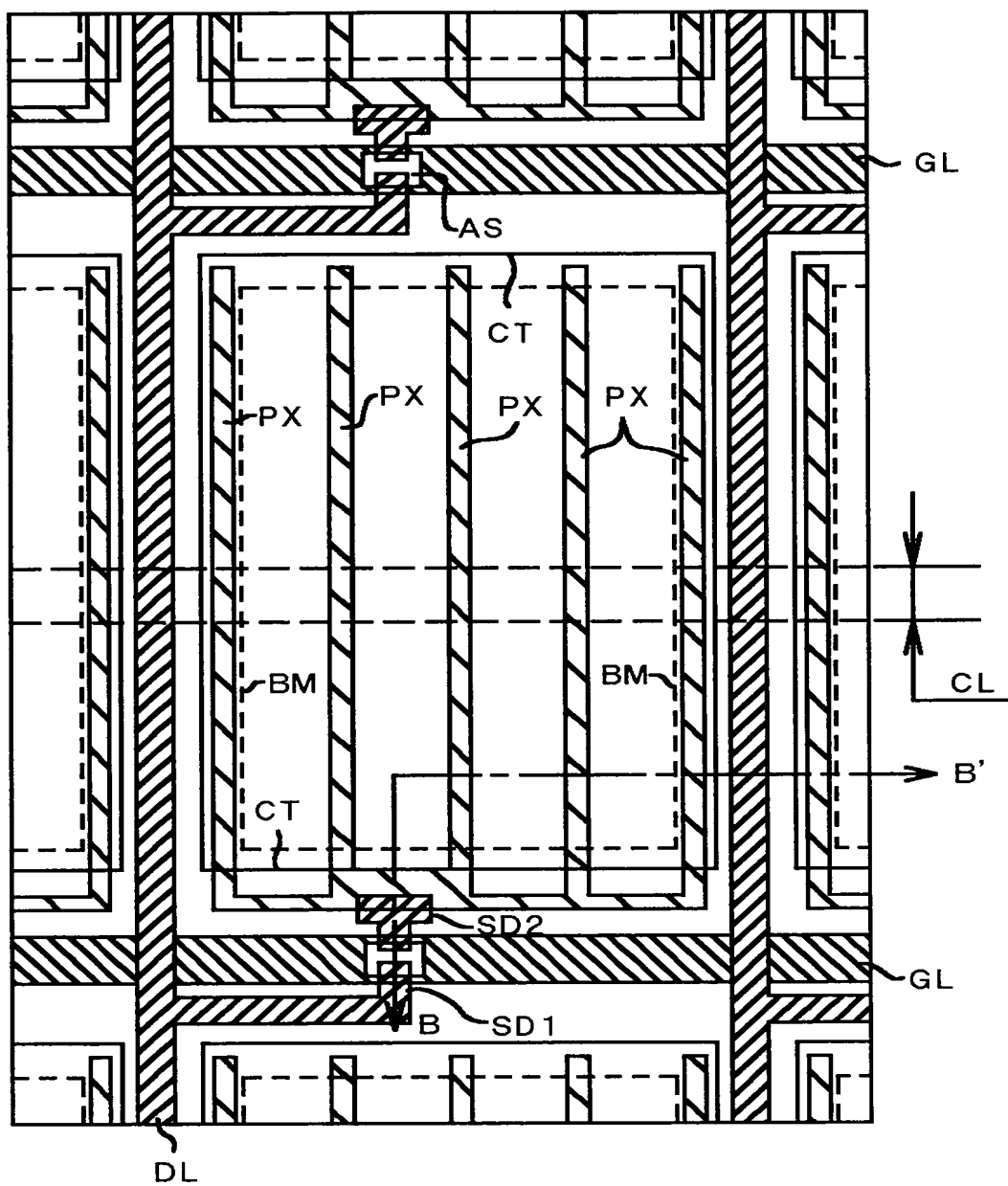
【図 6】

図 6



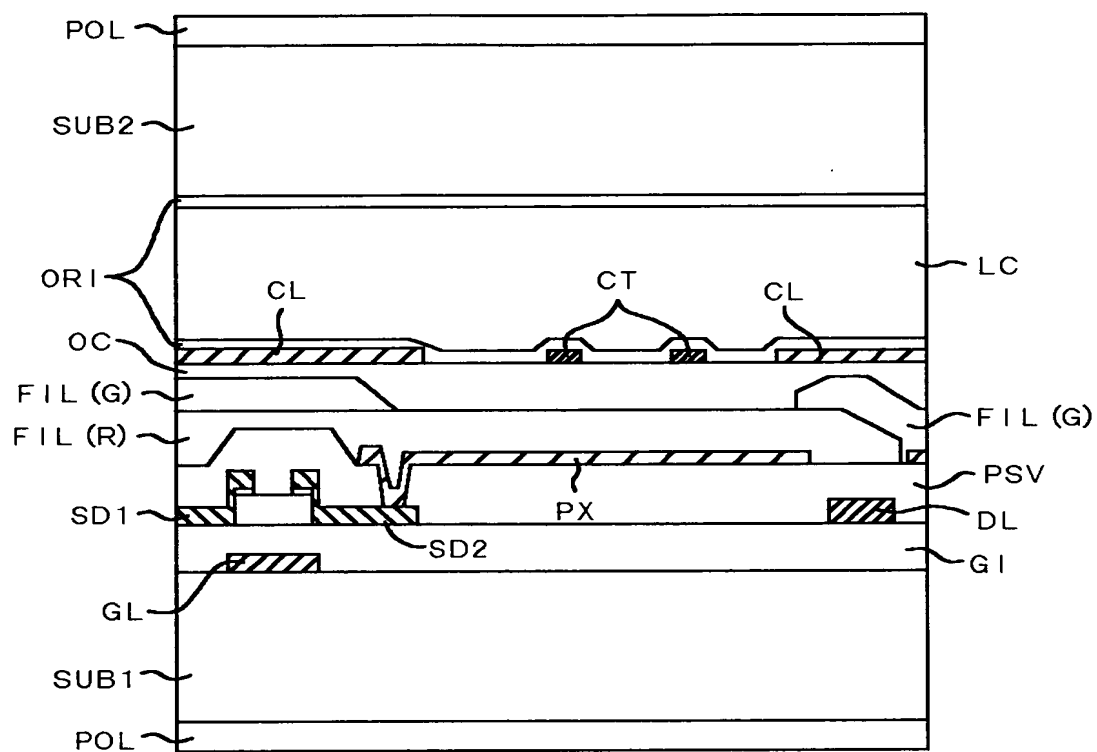
【図7】

図 7



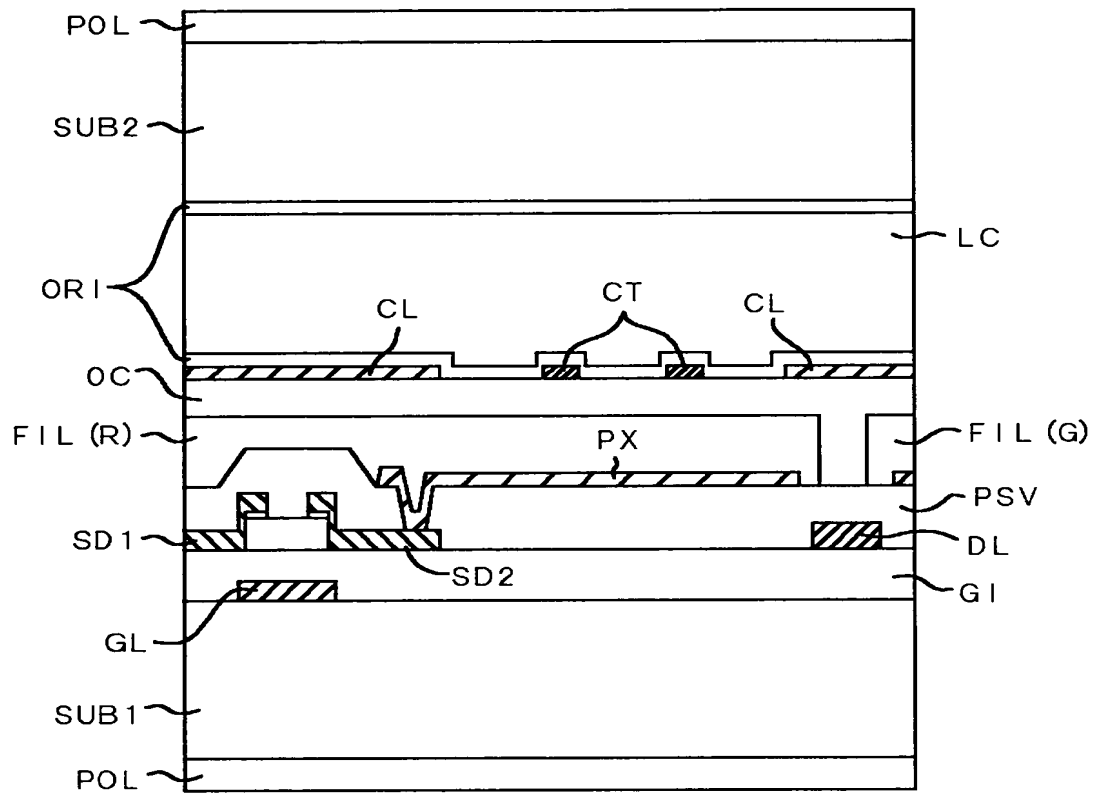
【図 8】

图 8



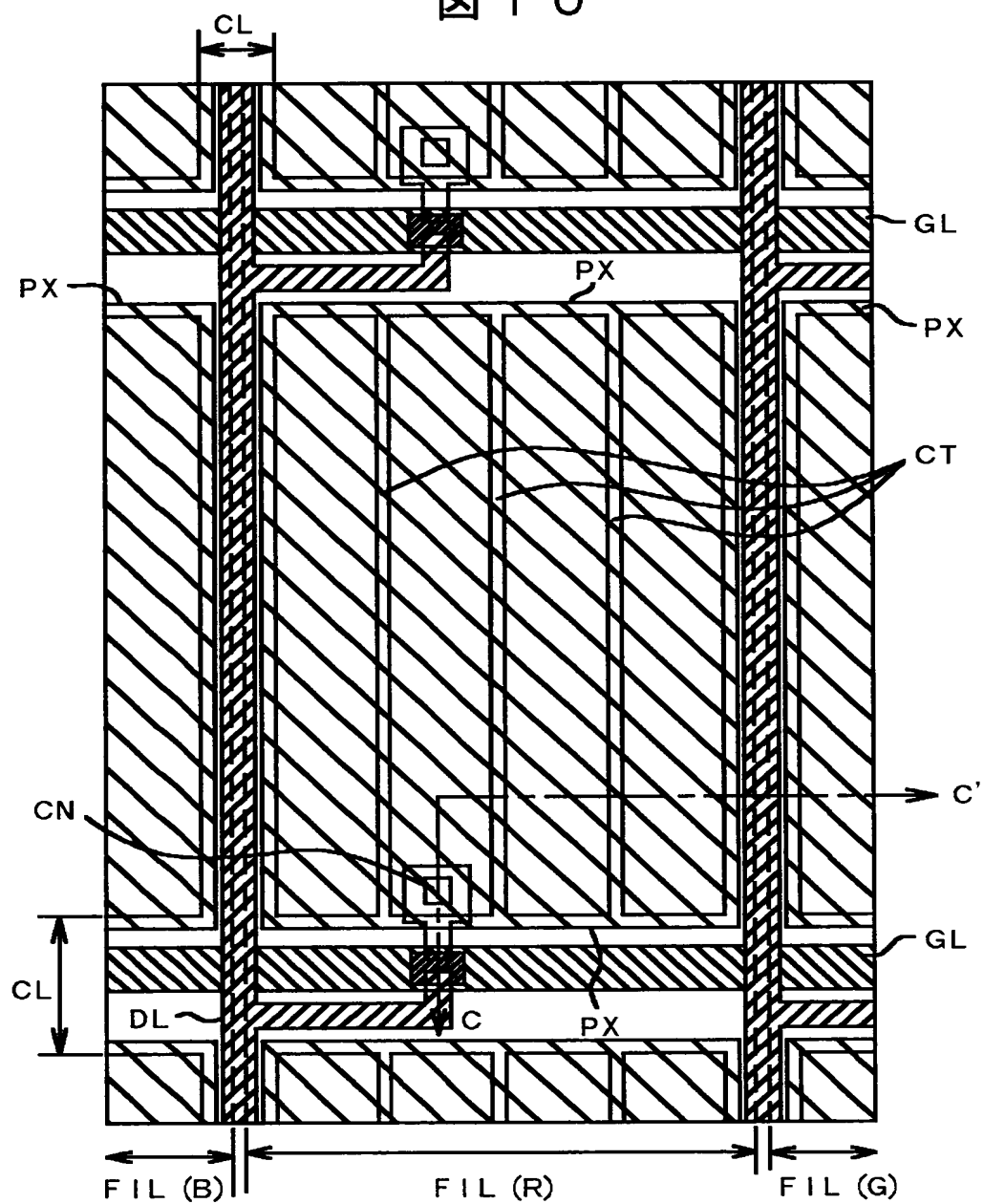
【図9】

図 9



【図10】

図 10



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 T F T 基板上にカラーフィルタを内蔵し、さらに視野角が広く明るい T F T 液晶表示装置を提供する。

【解決手段】 第1と第2の透明な基板と、前記第1と第2の基板間に挟まれた液晶層を有し、前記第1の基板は複数の映像信号線、複数の走査信号線、及び前記映像信号線と前記走査信号線に囲まれた領域として形成される複数の画素領域を有し、各画素領域は少なくとも1つのアクティブ素子と画素電極と共通電極とを有し、該画素電極と前記液晶層の間にカラーフィルタを有する液晶表示装置において、前記共通電極は前記カラーフィルタより上層に形成され、前記画素電極は前記カラーフィルタより下層に形成され、前記カラーフィルタは前記画素領域において少なくとも前記画素電極全面に重畳している。

【選択図】 図 1

特2001-019386

認定・付加情報

特許出願の番号	特願2001-019386
受付番号	50100114291
書類名	特許願
担当官	第二担当上席 0091
作成日	平成13年 1月30日

<認定情報・付加情報>

【提出日】 平成13年 1月29日

次頁無

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号 [000005108]

1. 変更年月日	1990年 8月31日
[変更理由]	新規登録
住 所	東京都千代田区神田駿河台4丁目6番地
氏 名	株式会社日立製作所